

单位: mil

## LPVBG25A

### 产品特性:

尺寸

芯片尺寸: 11mil x 25mil  
(275±25μm x 625±25μm)

芯片厚度: 4.6mil(115±15μm)

焊盘尺寸: 2.6mil(67±10μm)

焊盘金属

P焊盘: 金

N焊盘: 金



LatticePower

## 产品介绍

Product Introduction

# LPVBG25A



LatticePower

## 产品介绍

Product Introduction

# LPVBG25A

## 最大额定值

DC 正向电流	150mA
正向峰值电流 (1/10占空比@1kHz)	240mA
LED结温	115°C
反向电压	5V
使用温度范围	-40 ~ 85°C
贮存温度范围	0 ~ 40°C

### 说明:

1. 最大额定值为晶能光电封装条件下测试得到, 不同封装形式得到的值会有所不同, 建议在不超过最大额定值的条件下使用, 超过最大额定值使用可能会引起LED芯片损坏。
2. 本产品非设计与逆向电流 (压) 下使用, 不建议在任何逆向电流 (压) 下使用。

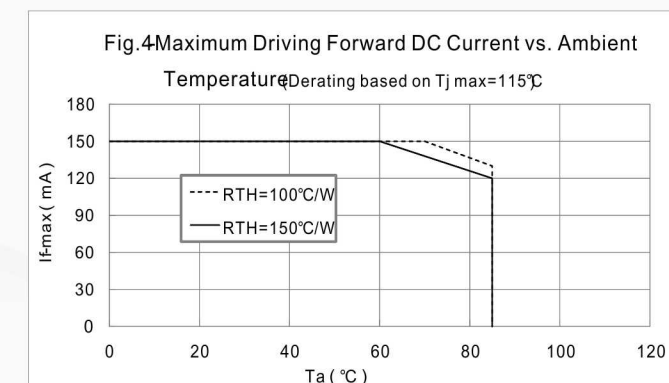
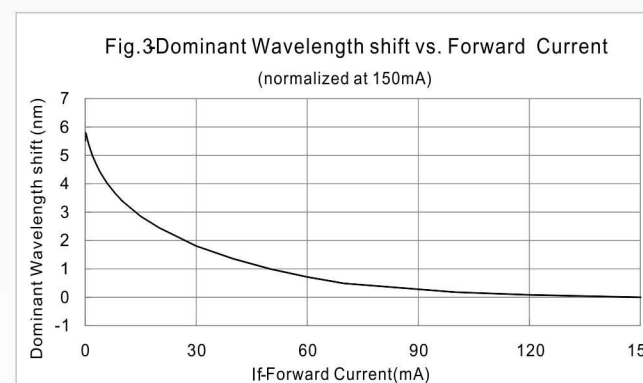
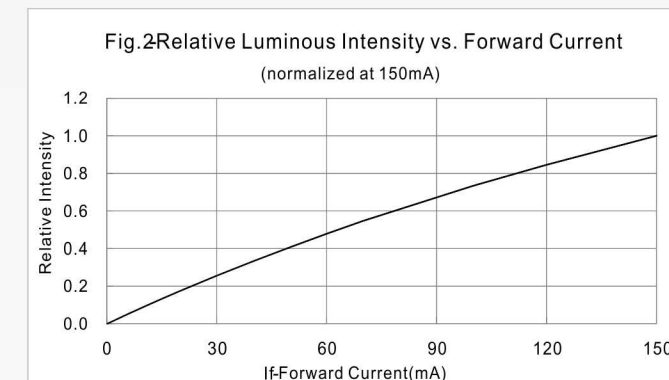
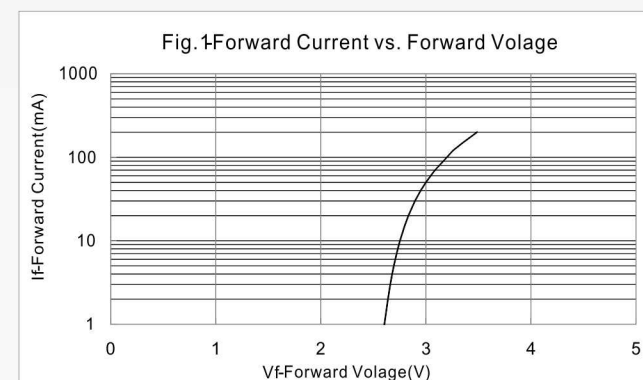
## 光电参数

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
开启电压	V <sub>f1</sub>	I <sub>f</sub> =10μA	2.0	---	2.8	V
工作电压	V <sub>f2</sub>	I <sub>f</sub> =150mA	3.0	---	3.6	V
反向漏电流	I <sub>R</sub>	V <sub>r</sub> =5V	---	---	1	μA
主波长	λ <sub>d</sub>	I <sub>f</sub> =150mA	445	---	475	nm
半波宽度	Δλ	I <sub>f</sub> =150mA	---	---	30	nm
光强	P <sub>o</sub>	I <sub>f</sub> =150mA	110	---	150	mW

## 参数等级:

P <sub>o</sub> (mW) \ W <sub>d</sub> (nm)	447.5-450	450-452.5	452.5-455	455-457.5	457.5-460	460-462.5
140-150	FBIW	GAIW	GBIW	HAIW	HBIW	IAIW
130-140	FBHW	GAHW	GBHW	HAHW	HBHW	IAHW
120-130	FBGW	GAGW	GBGW	HAGW	HBGW	IAGW
110-120	FBFW	GAFW	GBFW	HAFW	HBFW	IAFW

## 特性曲线



### 其它说明:

1. 光电参数为采用晶能光电测试仪器在室温下 (TA=25°C) 测试结果;
2. GaN 芯片为静电敏感产品, 请在使用、运输时注意静电保护;
3. 可根据客户要求订做特殊规格芯片。

LatticePower

LatticePower